



# 特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第6241848号

(PATENT NUMBER)

発明の名称  
(TITLE OF THE INVENTION)

薄膜トランジスタの構造、薄膜トランジスタの  
製造方法および半導体装置

特許権者  
(PATENTEE)

茨城県つくば市千現一丁目2番地1

国立研究開発法人物質・材料研究機構

発明者  
(INVENTOR)

生田目 俊秀  
相川 慎也

その他別紙記載

出願番号  
(APPLICATION NUMBER)

特願2014-016632

出願日  
(FILING DATE)

平成26年 1月31日(January 31, 2014)

登録日  
(REGISTRATION DATE)

平成29年11月17日(November 17, 2017)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。  
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成29年11月17日(November 17, 2017)

特許庁長官  
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

宗像直子



特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

(続葉 1)

特許第6241848号 (PATENT NUMBER)

特願2014-016632 (APPLICATION NUMBER)

発明者  
(INVENTOR)

おき希彦  
た麻伸一  
津水 越  
木清三 塚

[以下余白]